研究スタッフ

教 授: 齊藤 伸、 准教授: 角田 匡清 助 教: 小川 智之、日向 慎太朗 技術職員:小野寺 政信、特任教授:飛世 正博

研究目的

本研究室では、スパッタ法を中心としたドライプロ セスならびに化学合成を中心としたウェットプロセス を駆使することによって、超高密度磁気記録媒体、高 性能・高感度を有するMRAM・SVヘッドおよび高周 波デバイスを実現し得る、新たな材料設計・プロセス 技術の確立を目指している。

主な研究テーマ



perpendicular recording

Composition modulated atomic layer stacking for high- K_u **material** $Co_{80}Pt_{20}$ (T_{sub} = const. 300 °C, P_{Ar} = 2.0 Pa) HAADF-STEM images HAADF-STEM



stacking (Pt poor/rich) are formed.



Fcc stacking as faults in macroscopic of hcp phase accompanies with irregularities for the periodicity of the compositional modulation

In-line UHV sputtering machine





Image: Atom position + compositional contrast

ncident electron ray Sample Scattered ray

http://www.ecei.tohoku.ac.jp/electronic_physics/



齊藤・角田研究室

http://www.ecei.tohoku.ac.jp/electronic_physics/